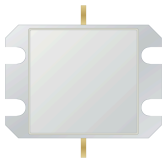
5700–7100 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 51 dBm (típico)

LCT-5700-7100-PS51T · 5700–7100 MHz · GaN Transistor de potência com casamento interno.



Valores da tabela RF: PSAT 51 dBm (típico); Ganho de potência 11 dB (típico); PAE 45 % (típico). Condições de teste RF: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs.

CMW025B

Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno.

Vg: C = 10 µF

Características RF

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	f	5700	-	7100	MHz
Potência de saída saturada	-	50.5	51	-	dBm
Ganho de potência	-	10.5	11	-	dB
Eficiência de potência adicionada	-	40	45	-	%
Planicidade do ganho de potência	-	-	-	1.5	dB

Polarização DC e correntes

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Tensão de operação do dreno	-	-	-	-	28	V
Tensão de operação da porta	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão dreno-fonte máxima	-	-	-	32	V
Polarização mínima da porta	-	-5	-	-	V
Temperatura de armazenamento	-	-65	-	150	°C
Potência de entrada máxima	-	-	-	42	dBm

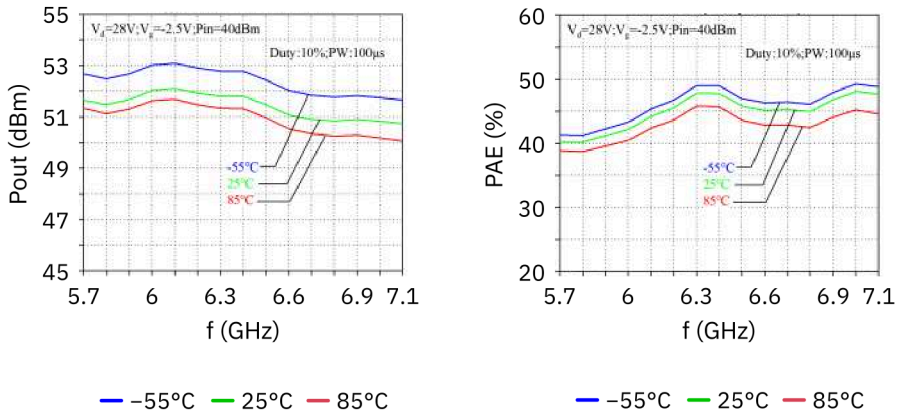
Registro da publicação atual · 1.5 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.4.

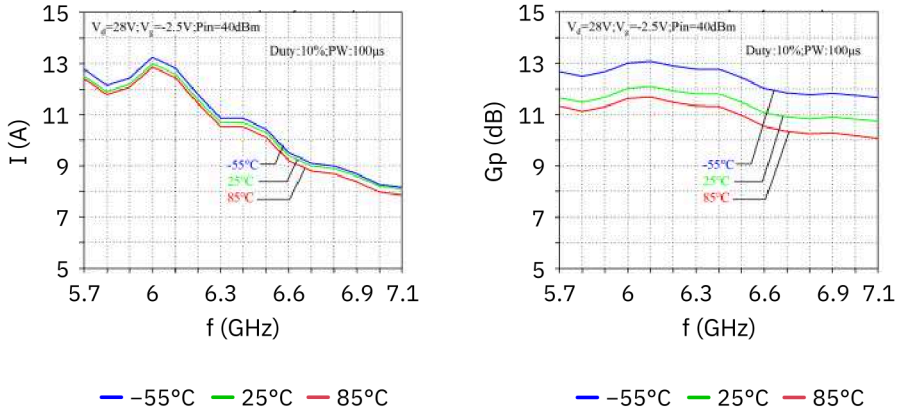
Notas de integração

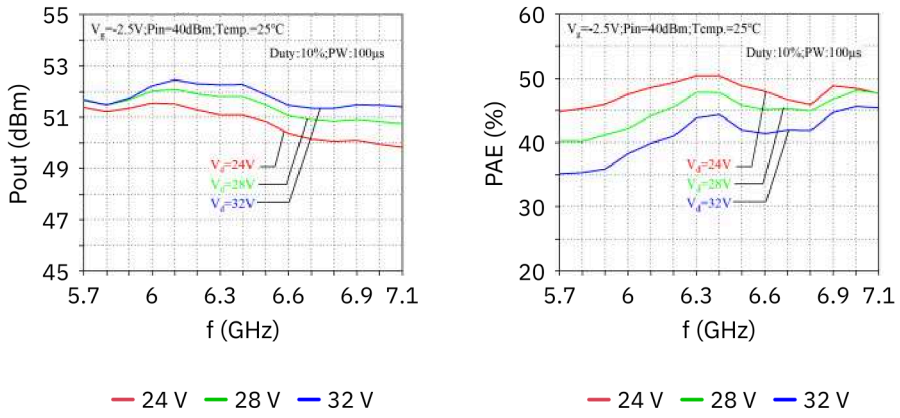
CMW025B Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno. Vg: C = 10 µF G: Entrada RF D: Saída RF S: Fonte / terra

Curvas de desempenho

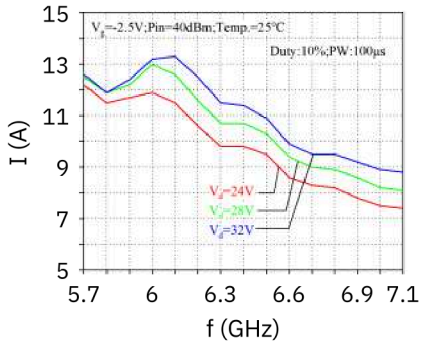
Considere as condições de operação indicadas em cada figura.

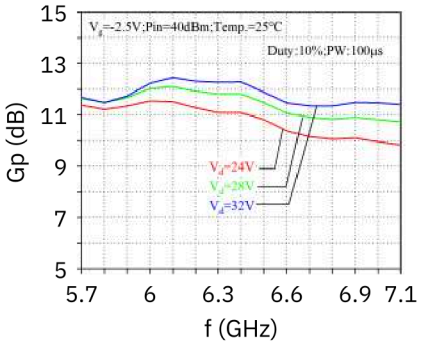


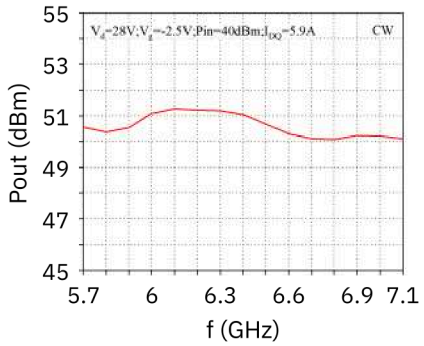


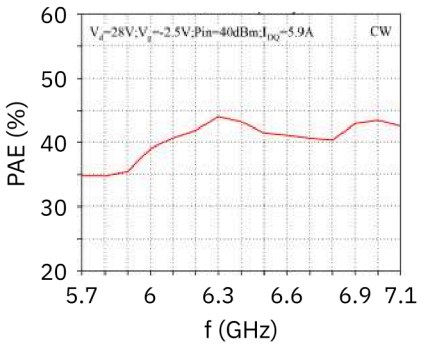


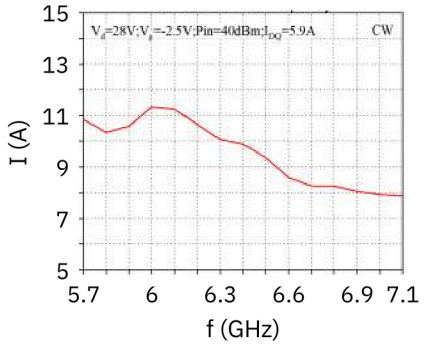
Potência de saída; Eficiência de potência adicionada; Corrente de dreno; Ganho de potência. Gráficos 1–4: Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs; Temp = −55 / +25 / +85°C. Gráficos 5–6: Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs.

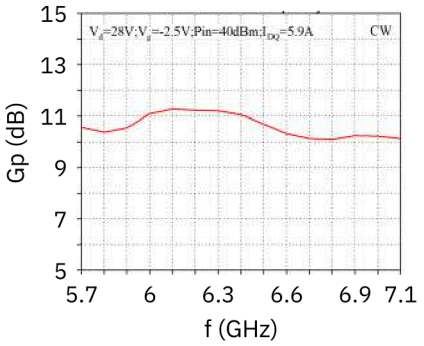




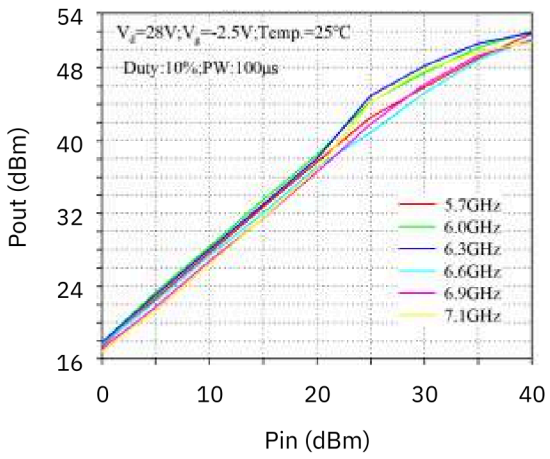




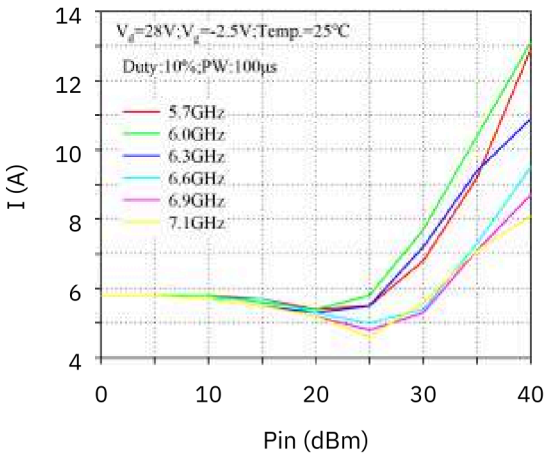




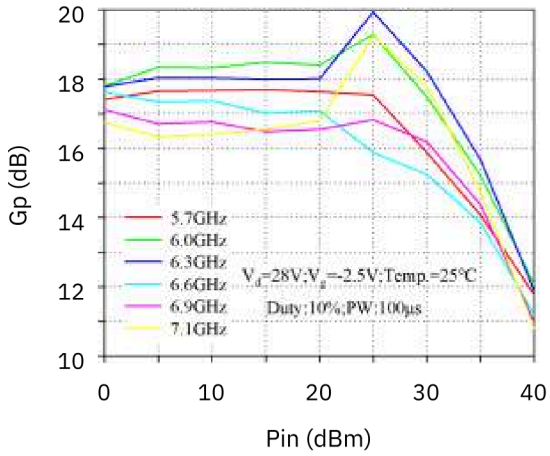
Potência de saída; Eficiência de potência adicionada; Corrente de dreno; Ganho de potência. Gráficos 1–2: Id, Gp; Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs. Gráficos 3–6: Pout, PAE, Id, Gp; Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; IDQ = 5.9 A; CW.



5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz



5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz



5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

Potência de saída; Corrente de dreno; Ganho de potência. Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs; Pin = 0–40 dBm.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.